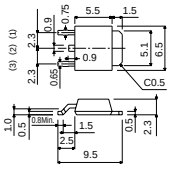
High-current gain Power Transistor (60V, 3A)

2SD2318

●Features

1) High DC current gain.
2) Low saturation voltage.
   (Typ. V_{CE}(sat) =0.5V at I_C / I_B=2A / 0.5A)
3) Complements the 2SB1639.

●External dimensions (Units : mm)



ROHM : CPT3
EIAJ : SC-63

(1) Base(Gate)
(2) Collector(Drain)
(3) Emitter(Source)

●Absolute maximum ratings (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Collector-base voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-emitter voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-base voltage	V_{EBO}	6	V
Collector current	I_C	3	A
		4.5	A(Pulse) *
Collector power dissipation	P_C	1	W
		15	W(Tc=25˚C)
Junction temperature	Tj	150	˚C
Storage temperature	Tstg	-55~+150	˚C

* Single pulse Pw=100ms

●Packaging specifications and h_{FE}

Type	2SD2318
Package	CPT3
h_{FE}	UV
Code	TL
Basic ordering unit (pieces)	2500

●Electrical characteristics (Ta=25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
Collector-base breakdown voltage	BV_{CBO}	80	-	-	V	I_C=50μA
Collector-emitter breakdown voltage	BV_{CEO}	60	-	-	V	I_C=1mA
Emitter-base breakdown voltage	BV_{EBO}	6	-	-	V	I_E=50μA
Collector cutoff current	I_{CBO}	-	-	100	μA	V_{CB}=80V
Emitter cutoff current	I_{EBO}	-	-	100	μA	V_{EB}=6V
Collector-emitter saturation voltage	$V_{CE(sat)}$	-	-	1.0	V	I_C/I_B=2A/0.05A *
Base-emitter saturation voltage	$V_{BE(sat)}$	-	-	1.5	V	I_C/I_B=2A/0.05A *
DC current transfer ratio	h_{FE}	560	-	1800	-	V_{CE}/I_C=4V/0.5A
Transition frequency	f_T	-	50	-	MHz	V_{CE}=5V, I_E=-0.2A, f=10MHz
Output capacitance	Cob	-	60	-	pF	V_{CB}=10V, I_E=0A, f=1MHz *

* Measured using pulse current.

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9